

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
【発行日】令和 7 年 3 月 3 日(2025.3.3)

【公開番号】特開 2023-146053(P2023-146053A)  
【公開日】令和 5 年 10 月 12 日(2023.10.12)  
【年通号数】公開公報(特許)2023-192  
【出願番号】特願 2022-53039(P2022-53039)  
【国際特許分類】

H 1 0 D 3 0 / 6 0 ( 2 0 2 5 . 0 1 )

10

【 F I 】

H 0 1 L 2 9 / 7 8 3 0 1 X

H 0 1 L 2 9 / 7 8 3 0 1 W

H 0 1 L 2 9 / 7 8 3 0 1 B

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 2 月 20 日(2025.2.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 8 3

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 8 3 】

このような半導体層によれば、第 4 半導体部よりも、バンドギャップが大きく、かつ比誘電率が大きい誘電体部を実現し易い。

30

40

50